Multi-Wire Beam Profile Monitor for J-PARC 3-50 BT and MR

Yoshinori Hashimoto^{1,A)}, Suguru Muto^{A)}, Takeshi Toyama^{A)}, Dai Arakawa^{A)}, Masahiko Uota^{A)}, Yoshio Saito^{A)},

Masashi Shirakata^{A)}, Youichiro Hori^{A)}, Yutaka Yamanoi^{A)}, Daisuke Ohsawa^{B)}, Teruhisa Morimoto^{C)}, Minoru Mitani^{D)}

^{A)}High Energy Accelerator Research Organization (KEK)

1-1 Oho, Tsukuba Ibaraki, 305-0801

^{B)} Kyoto University

Radioisotope Research Center, Kyoto University, 606-8501 Kyoto

^{C)} Morimoto Engineering

13-102 Iruma-River-Side, 603-1 Bushi, Iruma Shi, Saitama, 358-0053

^{D)} Minotos Engineering

1-16-28 Naka, Kunitachi, Tokyo, 186-0004

Abstract

For injection beam on main ring (MR) of Japan Proton Accelerator Research Complex (J-PARC), multi-wire type beam profile monitors (MWPM) was made. MWPMs were located into the injection beam line of 3-50BT and injection point of MR. Their targets were 32 or 64 channel array of gold coated tungsten (W) wire of which diameter was 30 micron. Secondary electrons emitted from the target caused by proton beam hitting were measured on each wire. It is feature that charges are transmitted with no amplifier about 400 meters maximum from the target to a signal processing module located in local control room. Then, signals are amplified, integrated, and converted into digital of ten bits depth by the module consists of 32 channels.

This paper will be described about manufacturing methods for the equipment mainly, and also first beam measurements.

J-PARC 3-50 BTとMRのマルチワイヤービームプロファイルモニター

1. はじめに

大強度陽子加速器であるI-PARC MRのビームトラ ンスポート(設計ビーム電流:4×10¹³ ppb)におい て、ビームプロフィルを計測するための簡便かつ確 実な方法として、マルチワイヤータイプの2次電子 計測モニターを採用した.破壊型ではあるが、ビー ムが一回通過であり、またターゲットでのエネル ギー損失が大きくないので運転中に常時使用できる. 大強度の場合、ビームロスによる真空中の発熱を 考慮し、ターゲットの材質には金属もしくは無機質 の物質が使われる.2次電子の放出率は、は、材質 によって数倍程度の差異であるので[1,2],静温時と 発熱時とのヒートサイクルでの変形によるダメージ を受けないような物質を使う必要がある. 耐熱性の 観点からは、高い融点を持つことが望ましく、タン グステン(融点:3387℃)などのワイヤーや、チタ ン(融点:1675℃)などの数ミクロンの薄いフォイ ルが使われる. ロスを少なくする観点からは, 原子 番号の小さな物質が良い.また,金属薄膜などをリ ボン化することで、出射される2次電子の量がワイ ヤー型に比べて大きく取れる. このためビーム周辺 の密度の低い領域までの計測が可能となる.使用す るワイヤーやリボンは、エミッションが均一である 必要がある. J-PARC MRでは、カーボンリボンを候 補にして、開発を進めているが、今回のビームコ ミッショニング(DAY-1)には、250 mm 四方以上の 大きなサイズの製作が間に合わなかったため,

KEK-PSやNMLビームラインで実績のある30 μm φ のタングステン(W)ワイヤーを用いた.

2. MWPM装置の配置

インストールされたMWPMは計6台であり,全長230 mの3-50 BTラインでは、上流部のRCSからの入射 ビームのための2台(#1, #2)、コリメータ直後に#3, 下りのスロープを終え下流の水平部に#5,入射直前 に#9の計5台である.完成時には全9台となる予定 である.MRの入射地点では、3-50 BTからの入射 ビームとMRを周回してきたビーム(1回に限る)を 計測する#INJが1台である.配置概略を図1に示す.



図1:3-50 BT及びMR入射点のMWPM配置概略図.

3. MWPM装置

3.1 真空容器と駆動機構

3-50 BTの標準的なMWPM装置図を図2に示す.ビー

ムパイプ内径は200 mm ϕ であり,ストロークは250 mmである.3-50-#1とINJが例外で,3-50-#1では, ターゲットチェンバーのビームパイプ内径が230 mm ϕ で,ストロークが300 mmである.INJは,スト ロークが430 mm である.

駆動には直線導入機を用いており、これは将来に 1 µm程度の薄いターゲットを取り付けるために、移 動時の衝撃などを極力避けたいことと、動作中に真 空内のケーブルが動かないようにするためである.



図2: 標準型の3-50BTのMWPM装置

ステージベッドの上に、計測チェンバーと直線導入 機が載る構造である. 直線導入機は、スライドレー ルに載っており、メンテナンス時には、計測チェン バーと成型ベローズ間のクイッククランプを外し、 200 mm 程度着脱位置まで引き出し、吊り上げて外 す.取付時は逆であり、脱着の再現性が高く、微調 整は不要である. 伸縮部には耐久使用回数10万回の 溶接ベローズが使用されており、レイデント皮膜 (防錆)を施したLMガイド上をターゲットを連結し たシャフトは直線動作する. ボールネジのベアリン グ類には、耐放射線を考慮し、モレスコグリースを 使用した.動力には、KEKで実績のあるサーボレス ACモータを用い、速度は、約1 mm/s である.

表1. 各MWPMとターゲットパラメータ

| | ц 111 11 | 1 101 C | / // | |
|------------|----------|---------|------------|-----------------|
| MWPM Name | Dir. | Ch. | Pitch [mm] | Beam Size [mm] |
| 3-50 BT #1 | Н | 32 | 4.0 | 40~120 |
| | V | 64 | 3.5 | 80~180 |
| 3-50 BT #2 | н | 32 | 3.5 | 50~101 |
| | V | 32 | 4.5 | 67 ~ 133 |
| 3-50 BT #3 | н | 32 | 2.5 | 35~43 |
| | V | 32 | 3.5 | 71~87 |
| 3-50 BT #5 | н | 32 | 4.0 | 73~115 |
| | V | 32 | 2.5 | 50~81 |
| 3-50 BT #9 | н | 32 | 4.0 | 90~126 |
| | V | 32 | 2.5 | 36 ~ 73 |
| INJ | н | 64 | 4.5 | 60 |
| | V | 32 | 5.5 | 100 |

3.2 リボンピッチ

リボンピッチは、各MWPMの位置でのビームサイズ から決定した.チャンネル数は、処理回路に合わせ て32ch を基本とし、広範囲なプロファイルが必要 な場所で、2倍の64ch とした.表1に、各MWPMのch 数、ピッチ、予想されるビームサイズをまとめる.

3.3 ターゲットフレーム

3-50 BT用の標準的なターゲットの写真を図3に示 す. セラミック基板サイズ(H×V)は、外300×280, 内200×200 mm² であり、H用ワイヤー. 電子収集膜 (Ti-foil:1.2 μ m)、V用ワイヤーの3枚が、額縁型の アルミフレーム(写真一番奥)の上に、10 mm 間隔 で構成されている.

ターゲットフレームは、セラミックス(Al₂0₃: 99.6%),厚み3 mm であり,焼結後の平坦度は、 0.1mm である.ワイヤー用ターゲットのフレーム表 面の電極とリード線のパターンの焼成材質は、AgPt とAu である.AgPtをメインの配線部に使用してい るのは、ワイヤー電極部の半田付けでの熱負荷がか かる場合でも、セラミックスに対する付着強度が高 いためである.ケーブル接続部では、Auを使用して いる.金メッキした燐青銅のコンタクトピンのセラ ミックスコネクタで、圧接するためである.



図3:3-50BT用MWPMの標準的なターゲット基板.

今回のような比較的大きな300 mm程度四方のフ レーム型セラミックス基板に、AgPt とAu のパター ンを焼成するには、いくつかの技術が必要である. 厚膜印刷したAgPtでは、850℃の温度にて、酸素 リッチな雰囲気中での焼成(約10分)が必要であるが、 昇降温時には急激な温度変化を避けなければならな い.残留応力のためコーナー近辺にクラックが発生 するためである.約1 m³程度の内容積をもつ電気 炉を用いて5L/min 程度の酸素ガスを供給しながら、 約30時間をかけて昇降温させて製作した.また、Au とAgPt の接合部では、Auの異常拡散により接合部 が収縮し、パターンが破断する問題が生じていたが、 Auを印刷、乾燥させた後、AgPtを印刷し、一度に AgPtの焼成温度850℃で焼成することができた.

3.4 タングステンワイヤー

30µm φ のAuコートのタングステン(W) ワイヤーは, 直径のばらつきが±4%, Auコート厚みが0.3µm であ る.ビーム照射を行うとAu部は飛んでしまい,W だ けの状態となる.Auは,接合部での異種金属との半 田等の接合をなじませる役割をもつ.予めHIMACの ビームによる使用したワイヤーのエミッションのば らつきを測定したが,2%以下と良好な値を得た. フレーム上のAgPt電極との接合には,真空中での使 用を考慮し,InSn合金をフラックスなしで超音波半 田付けとした.ワイヤーへの張力は,50g とした.

3.5 真空内の信号ケーブル,コネクタ

ターゲットフレーム上のパターンは、セラミック スコネクタでケーブルに接続される.ターゲットを 含めてチェンバーとは絶縁を取っている.信号は、 断面積0.22 mm²のセラミック(40%)・シリコンヤー ン(60%)の被覆をもったツイストペアケーブル約 1.1m と、複数のバーンディータイプ22極のセラ ミックフィードスルーを通して大気側に導かれる. このケーブルのガス放出率は1 m 長さあたりで、排 気開始から100時間後に4×10⁻⁸ [Pa.m³/s] であり、 実際の使用時には、各MWPMチャンバー近傍で圧力は 10⁻⁶ Pa のオーダーであった.内径58 mmのシャフト 内のケーブル占有率は、凡そ1/3(H,V共に32ch)また は1/2(H,Vいずれか64CH)程度である.

4. 信号ケーブル,処理回路

信号用の34chの多芯同軸ケーブルは、今回のため にフジクラが製作した1.5D-QEBZ×34C EM-MCX-TAZE (外径37mm φ) である. 微弱な電荷(DAY-1では、pC オーダーもしくはそれ以下)を計測するために遮蔽 を強化してあり、電磁遮蔽に0.6 mm^tの電磁鋼帯を2 枚、その内側に静電遮蔽に0.7 mm^tのアルミニウム コルゲートを用いた. 1.5Dの各同軸信号線には縦添 えのアルミナイズドテープを巻き、100kHzまでの範 囲で漏話特性は-60dBである. 使用長さ最長約400 m で処理回路と装置を結ぶ. MRトンネル内には、前置 処理回路を置く場所は設けていないためである.



図4: CAMAC-MWPMモジュール.

信号処理回路(図4)には、KEK-NMLビームラインで

使用されていた10bit-32ch のADCを搭載したCAMAC-MWPMモジュールを転用した.入力部は2段のアンプ (400倍,入力抵抗1kΩ)と積分器(時定数33µs)で 構成されたハイブリッドICである.積分処理後に, マルチプレクサを通して,ターゲットワイヤーの一 番端に張ってあるBG計測用のワイヤー(33ch目)から の信号との差を取った後に,AD変換される.信号 ケーブルの電気容量は数10nFに上るため,電荷信号 がケーブルから放電される時定数は,100 µsのオー ダーを持つ.このため積分ゲート時間は,500µs 程 度としている.

ノイズ対策は十分にはできていないが、特に入射 時刻のパルス機器からの影響が大きい.処理回路の ACラインをノイズカットトランスで完全に絶縁し、 信号ケーブルのアルミコルゲートを装置側と処理回 路側の両端で接地することでかなり影響を受けにく くできることがわかってきた.ケーブル外側の電磁 鋼帯は、処理回路側での接地が効果があり、現在は A種の接地点に接続している.

5. ビームプロファイル

5月と6月に行われたMRのはじめてのビームコミッ ショニングにおいて、3-50BT MWPM-#1で計測された 水平方向のビームプロファイルを図5に示す.ビー ム強度は、4×10¹¹ ppb であり、設計値の約1/100で あった.またビームエミッタンスは、20 π mm. mrad 程度でり、設計の81 π mm. mrad よりもかなり小さ かった.計測は、MWPMモジュールのアナログ出力を スコープ上で10回の平均を取ったものであり、全幅 約20 mmであった.



図5:3-50BT-#1-Hの最初のビームプロファイル.

6. 今後の課題

カーボンリボンターゲットへの置き換えと、ノイ ズ対策が今後の課題である.

参考文献

- [1] S. A. Blankenburg, et. al, NIM, 39(1966)303.
- [2] M. Plum, Beam Instrumentation Workshop, May3-6 2004, Knoxville, TN.